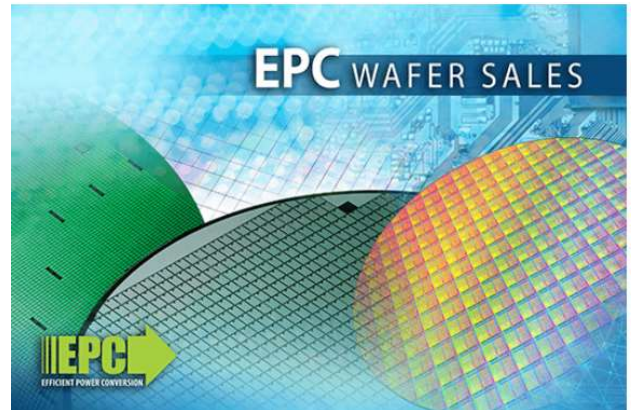


Wafer供給

Rev1.0

eGaN[®]

GaNの優れた特性を活かしながらチップへのインテグレーションを行って頂くために、EPCからのWafer供給が可能です。



主な供給方法

- Bump付Wafer
- Solder Bump無しWafer
UBM: 10 μ mPI+2KA Ti sputter +
4Ka Cu Sputter +
8 μ m Cu Plating
- その他のサービス
 - 厚み260 μ mまでのWafer研削加工
 - Wafer背面への薄膜形成
 - Ti/Ni/Au
 - Ti/Ni/Ag
 - 背面保護テープ

